

# METHOD FOR TRANSFERRING A THIN LAYER COMPRISING A STEP OF EXCESS FRAGILIZATION

Publication number: FR2797347

Publication date: 2001-02-09

Inventor: LAGAHE CHRYSTELLE; SOUBIE ALAIN; BRUEL MICHEL; ASPAR BERNARD

Applicant: COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE (FR)

Classification:

- International: H01L21/265; H01L21/02; H01L21/762; H01L27/12; H01L21/02; H01L21/70; H01L27/12; (IPC1-7): H01L21/304; H01L21/324

- european: H01L21/762D8B

Application number: FR19990010121 19990804

Priority number(s): FR19990010121 19990804

Also published as:



WO0111667 (A1)

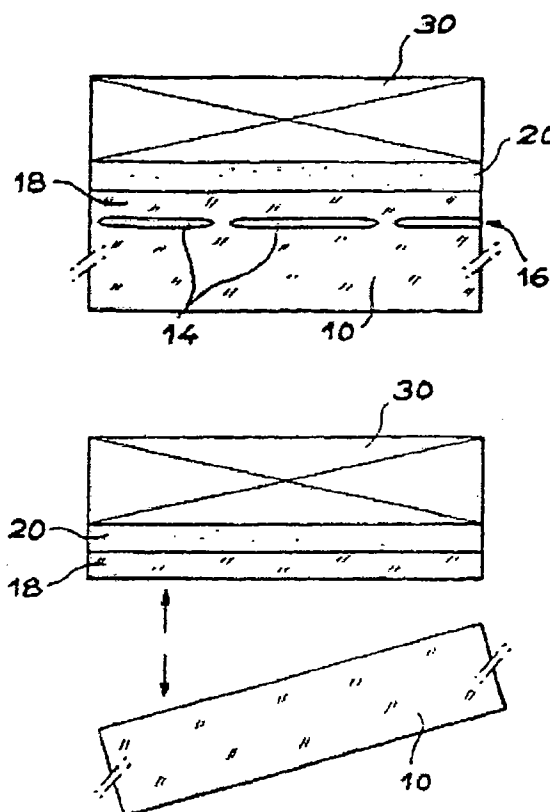
EP1203403 (A1)

EP1203403 (A0)

Report a data error here

## Abstract of FR2797347

The invention concerns a method for transferring a thin layer (18) from a source substrate (10) to a target support (30) comprising the following steps: a) implanting ions or gaseous species into the source substrate so as to form therein a zone (16) called cleavage zone, delimiting said thin layer (18) in the source substrate; b) transferring the substrate source onto the target support and making the thin layer integral with the target source; c) separating the thin layer (18) from the source substrate (10) along the cleavage zone. The invention is characterised in that the method comprises, prior to step b): a process for excess fragilization of the cleavage zone (16) produced by a heat treatment and/or by exerting mechanical stresses on the source substrate.



①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

①⑪ N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

2 797 347

①⑪ N° d'enregistrement national : 99 10121

⑤① Int Cl<sup>7</sup> : H 01 L 21/304, H 01 L 21/324

①⑫ DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 04.08.99.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la  
demande : 09.02.01 Bulletin 01/06.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO-  
MIQUE Etablissement de caractère scientifique techni-  
que et industriel — FR.

⑦② Inventeur(s) : LAGAHE CHRYSTELLE, SOUBIE  
ALAIN, BRUEL MICHEL et ASPAR BERNARD.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : BREVATOME.

⑤④ PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE COMPORTANT UNE ETAPE DE SURFRAGILISATION.

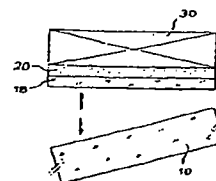
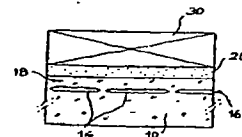
⑤⑦ Procédé de transfert d'une couche mince (18) d'un  
substrat source (10) vers un support cible (30) comportant  
les étapes suivantes:

a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans  
le substrat source de façon à y former une zone (16), dite de  
clivage, qui délimite ladite couche mince (18) dans le subs-  
trat source,

b) le report du substrat source sur le support cible et la  
solidarisation de la couche mince avec le support cible,

c) la séparation de la couche mince (18) d'avec le subs-  
trat source (10) selon la zone de clivage,  
conformément à l'invention le procédé comporte préala-  
blement à l'étape b):

- une surfragilisation de la zone de clivage (16) provo-  
quée par un traitement thermique et/ ou par l'exercice d'ef-  
forts mécaniques sur le substrat source.



FR 2 797 347 - A1



**PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE COMPORTANT UNE  
ETAPE DE SURFRAGILISATION**

Domaine technique

La présente invention concerne un procédé de  
5 transfert d'une couche mince d'un substrat, dit  
substrat source, vers un support appelé support cible.

L'invention trouve des applications en  
particulier dans les domaines de la micro-électronique,  
de la micro-mécanique, de l'optique intégrée et de  
10 l'électronique intégrée.

Elle permet, par exemple de réaliser des  
structures dans lesquelles la couche mince, qui est en  
un matériau sélectionné pour ses propriétés physiques,  
est reportée sur un support afin de former un  
15 empilement à plusieurs couches. Ainsi, on peut combiner  
les avantages des matériaux de la couche mince et du  
support. Le report d'une couche permet notamment  
d'associer dans une même structure des parties qui  
présentent a priori des incompatibilités telles qu'une  
20 différence importante de coefficients de dilatation  
thermique.

Etat de la technique antérieure

Le texte qui suit se réfère à un certain nombre  
25 de documents dont les références complètes sont  
précisées à la fin de la description.

Parmi les procédés généralement mis en oeuvre  
pour la formation de couches minces, on peut citer en  
particulier un procédé de clivage, bien connu sous la  
30 dénomination "Smart-cut", et illustré par le document  
(1).

Le procédé "Smart-cut" est basé essentiellement sur l'implantation d'hydrogène ou d'un autre gaz sous forme neutre ou ionique dans un substrat de façon à y former une zone de clivage fragilisée.

5 Dans le cas d'un substrat plan, la zone de clivage s'étend, de façon sensiblement parallèle à sa surface et est située dans le substrat à une profondeur fixée par l'énergie d'implantation. La zone de clivage délimite ainsi dans le substrat une couche  
10 superficielle mince qui s'étend en épaisseur depuis la zone de clivage jusqu'à la surface du substrat.

Une deuxième étape comprend la mise en adhérence du substrat source avec un support cible de telle façon que la couche mince soit solidaire du  
15 support cible. La fixation de la couche mince sur le support cible peut avoir lieu au moyen d'une colle et/ou par l'intermédiaire d'une couche de liaison. Elle peut avoir lieu également par adhérence moléculaire directe entre la surface du substrat et la surface du  
20 support cible.

Dans ce dernier cas, il est cependant nécessaire que les faces que l'on souhaite faire adhérer présentent certaines propriétés comme une bonne planéité et une faible rugosité.

25 Une dernière étape du procédé consiste à fracturer le substrat selon la zone de clivage pour en séparer la couche mince. Celle-ci reste alors solidaire du support cible.

Dans le cas du procédé décrit par le document  
30 (1), la fracture (ou clivage) du substrat est provoquée

par apport d'énergie sous forme d'un traitement thermique.

Les conditions d'implantation définissent la zone de clivage et conditionnent la séparation de la  
5 couche mince d'avec le substrat.

Or, on a observé qu'une trop grande fragilisation de la zone de clivage après l'implantation, bien que favorable pour la séparation, provoque des déformations de la surface de la couche  
10 mince. Les déformations se présentent sous la forme de cloques et constituent un obstacle pour la fixation de la couche mince sur le support cible.

Cette trop grande fragilisation, peut être liée à une implantation ionique à forte dose ou à une  
15 implantation ionique à plus faible dose associée à un recuit. La trop grande fragilisation peut donc induire l'apparition de cloques en surface d'autant plus facilement que la zone fragilisée est proche de la surface.

20 Dans certaines applications on souhaite obtenir des films minces autoportés, c'est-à-dire qui peuvent être séparée du substrat source sans être préalablement fixés sur un support.

Ces films minces peuvent alors être reportés  
25 ultérieurement sur différents supports cibles et, en particulier, sur des supports avec lesquels le substrat source ne peut pas être mis en adhérence avant la séparation de la couche mince, par exemple, pour des raisons de compatibilité des coefficients de dilatation  
30 thermique.

On peut à ce sujet se reporter au document (2) qui propose un procédé dérivé de celui du document (1).

Le document (2) propose un procédé permettant d'obtenir la séparation de son substrat d'origine, d'un  
5 film mince qui est autoporté. Pour cela, il faut que les espèces gazeuses implantées se trouvent à une profondeur suffisante et/ou que l'on dépose, après l'étape d'implantation, une couche d'un matériau permettant de rigidifier la structure pour obtenir la  
10 séparation au niveau de la zone implantée sans avoir de cloques:

L'illustration de la technique de formation d'une couche mince par clivage d'un substrat, peut être complétée par le document (3) qui suggère de compléter  
15 le traitement thermique de fracture (clivage) du substrat par l'exercice de forces mécaniques de flexion, de traction et/ou de cisaillement.

Le document (4) qui décrit également un procédé basé sur le principe établi par le document (1), montre  
20 que le budget thermique mis en oeuvre pour provoquer la fracture du substrat source dépend des budgets thermiques de tous les traitements thermiques imposés au substrat source depuis l'implantation jusqu'à la fracture.

25 On entend par budget thermique le couple durée de traitement thermique/température de traitement thermique.

Dans un certain nombre d'applications il est nécessaire d'assembler une couche mince d'un substrat  
30 source avec un support cible qui présente un

coefficient de dilatation thermique différent de celui du substrat source.

Dans ces applications, il est généralement délicat de soumettre la structure obtenue après  
5 assemblage du substrat source et du support cible, à un traitement thermique avec un budget thermique suffisant pour garantir la séparation de la couche mince d'avec le substrat source.

Une solution à ce problème consiste alors à  
10 modifier les conditions d'implantation en effectuant un surdosage des espèces implantées. Un tel surdosage permet en effet de réduire le budget thermique de la fracture de séparation (clivage).

A titre d'exemple, lorsque le substrat source  
15 est une plaque de silicium, une dose d'ions d'hydrogène implantés, de  $1.10^{17}/\text{cm}^2$  au lieu de  $6.10^{16}/\text{cm}^2$ , permet pour une durée de traitement thermique de quelques heures d'en abaisser la température de  $400^\circ\text{C}$  à  $280^\circ\text{C}$ .

La solution consistant à surdoser  
20 l'implantation n'est cependant pas toujours satisfaisante en raison de la différence de coefficient de dilatation thermique pouvant exister entre le substrat et le support. En effet, le budget thermique nécessaire à la séparation peut être tel qu'il provoque  
25 le déclollement du substrat et du support et/ou la cassure du substrat et/ou du support dans leur volume.

Une solution alternative pour éviter un décollement entre la couche mince et le support cible sous l'effet d'une dilatation différentielle, consiste  
30 à amincir le substrat source avant l'étape de fracture (clivage).

Cette solution, suggérée par le document (5), présente toutefois l'inconvénient d'une opération supplémentaire d'aminçissement et celui d'une consommation de matière importante.

5           La mise en oeuvre de forces mécaniques pour séparer le substrat source de la couche mince, telle qu'évoquée ci-dessus en référence au document (3), permet également de réduire le budget thermique de fracture, notamment dans le cas où les matériaux en  
10           contact présentent des coefficients de dilatation différents. L'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source et/ou le support cible n'est toutefois pas toujours possible, notamment lorsque les matériaux  
15           mis en oeuvre sont fragiles, ou lorsque la zone de clivage n'est pas assez fragilisée par l'implantation ionique.

          Finalement, les techniques de séparation et de transfert de couche mince, décrites ci-dessus, impliquent un certain nombre de contraintes et de  
20           compromis. Ces contraintes sont imposées en particulier par le type de matériaux utilisés pour constituer le substrat source, la couche mince et le support cible.

#### Exposé de l'invention

25           La présente invention a pour but de proposer un procédé de transfert d'une couche mince, ne présentant pas les difficultés et limitations des procédés indiquées ci-dessus.

          Un but est en particulier de proposer un tel  
30           procédé qui mette en oeuvre un budget thermique réduit

voir nul pour obtenir une fracture de séparation de la couche mince.

Un autre but est de proposer un procédé adapté au transfert d'une couche mince sur un support cible, dans lequel les matériaux de la couche mince et du support cible présentent des coefficients de dilatation thermique différents.

Encore un autre but est de proposer un procédé de transfert dans lequel un excellent état de surface du substrat source (sans cloques) peut être préservé de façon à autoriser une bonne adhérence avec le support cible, avec ou sans apport de liant (colle), et en permettant d'avoir une zone de clivage très fragilisée.

Enfin, un but de l'invention est de proposer un procédé de transfert permettant d'obtenir, après transfert, une couche mince sur le support cible, qui présente une surface libre avec une faible rugosité.

Pour atteindre ces buts, l'invention a plus précisément pour objet un procédé de transfert d'une couche mince d'un substrat source vers un support cible comportant, dans l'ordre, les étapes suivantes :

- a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans le substrat source de façon à y former une zone, dite de clivage, qui délimite ladite couche mince dans le substrat source,
- b) le report du substrat source sur le support cible et la solidarisation de la couche mince avec le support cible,
- c) la séparation de la couche mince d'avec le substrat source selon la zone de clivage.

Conformément à l'invention, le procédé comporte préalablement à l'étape b),

- une formation d'une épaisseur de film de matériau entre la zone de clivage et la surface du substrat telle que cette épaisseur soit supérieure,  
5 égale ou voisine d'une épaisseur limite pour laquelle le film est autoporté, et

- une surfragilisation de la zone de clivage provoquée par un traitement thermique et/ou par  
10 l'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, l'étape de formation d'une épaisseur de film consiste à réaliser l'étape a) d'implantation de façon à obtenir la zone de clivage à ladite épaisseur,  
15 le film étant alors constitué par la couche mince.

Selon un deuxième mode de réalisation de l'invention, l'étape de formation d'une épaisseur de film consiste à réaliser une étape de formation d'une couche dite d'épaisseur sur la couche mince, la  
20 couche mince et la couche d'épaisseur formant alors le film.

L'épaisseur limite du film est l'épaisseur permettant de rigidifier la structure pour obtenir la séparation du film au niveau de la zone de clivage sans  
25 apparition en surface de cloques. C'est cette épaisseur limite qui permet d'obtenir des films autoportés. Cette épaisseur dépend en particulier des propriétés mécaniques des matériaux, mais aussi des conditions de séparation de l'étape c) telle que par exemple la  
30 montée en température du traitement thermique.

Selon un mode avantageux, l'invention comporte également la réalisation, avant l'étape b), de tout ou partie de composants micro-électriques et/ou micro-mécaniques et/ou optoélectroniques.

5 La séparation de la couche mince d'avec le substrat source, opérée à l'étape c), peut avoir lieu sous l'effet d'un traitement thermique, sous l'effet d'efforts mécaniques ou sous l'effet de ces actions combinées.

10 Or, grâce à l'étape de surfragilisation, le budget thermique et/ou les efforts mécaniques mis en oeuvre lors de l'étape c) pour la fracture de séparation peuvent être particulièrement réduits. Ceci a pour avantage de ne pas provoquer de rupture  
15 d'adhérence entre le film mince et le support cible, même en cas d'une différence des coefficients de dilatation thermique des matériaux mis en contact.

Un autre avantage de l'invention est de supprimer ou réduire les efforts mécaniques exercés sur  
20 les parties en contact et éviter ainsi de les détériorer. On facilite ainsi la séparation.

Il convient de noter que l'étape de surfragilisation n'induit pas de contraintes de dilatation différentielle dans la mesure où cette étape  
25 est effectuée avant le report du substrat source sur le support cible (étape b).

Selon un aspect avantageux, la surfragilisation comporte un traitement thermique mis en oeuvre avec un budget thermique supérieur ou égal à 50%, et de  
30 préférence supérieur à 60%, d'un budget thermique global permettant la séparation.

Le budget thermique global considéré ici prend en compte non seulement les traitements thermiques opérés dans le strict cadre du procédé de l'invention, mais comprend également d'éventuels traitements  
5 thermiques mis en oeuvre, par exemple, pour la réalisation de composants ou pour le dépôt de matériaux sur la couche mince entre les étapes a) et b).

Comme évoqué précédemment, les étapes c) et l'étape de surfragilisation peuvent comporter un  
10 exercice d'efforts mécaniques.

Ces efforts mécaniques comprennent, par exemple, l'application de forces sous la forme d'une pression mécanique et/ou d'une tension mécanique et/ou des forces sous la forme d'une pression de gaz.

15 Le traitement thermique de séparation peut aussi être choisi suffisant pour provoquer lors de l'étape c) une séparation de la couche mince, par simple écartement du substrat source et du support cible.

20 L'étape d'implantation a) permet de former dans le substrat source des cavités situées dans la zone de clivage.

Les cavités (ou micro-cavités ou platelets ou microbulles) peuvent se présenter sous différentes  
25 formes. Elles peuvent être sphériques et/ou aplaties avec une épaisseur de seulement quelques distances inter-atomiques. Par ailleurs, les cavités peuvent contenir une phase gazeuse libre et/ou des atomes de gaz issus des ions implantés, fixés sur les atomes du  
30 matériau formant les parois des cavités.

Les traitements thermiques subis par le support source, et en particulier un traitement thermique de surfragilisation du procédé, conduisent à la coalescence de tout ou partie des cavités. La coalescence provoque ainsi la surfragilisation du substrat dans la zone de clivage.

Ce phénomène permet en outre d'obtenir, après le report et la fracture de séparation, une surface libre de la couche mince avec une faible rugosité.

La couche d'épaisseur, par exemple en Si, SiO<sub>2</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ou encore SiC, recouvre la couche mince en tout ou partie. L'épaisseur de la couche d'épaisseur pour obtenir une épaisseur de film est choisie par exemple dans une gamme allant de 3 à 10 µm pour un épaisseur SiO<sub>2</sub>.

Il convient de préciser qu'une couche utilisée comme couche d'épaisseur peut être une couche qui sert également en tout ou partie à la réalisation de composants électroniques, optoélectroniques, ou mécaniques à la surface de la couche mince.

L'invention concerne également un procédé de transfert d'une couche mince d'un substrat source comportant les étapes suivantes :

- a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans le substrat source de façon à y former une zone, dite de clivage, qui délimite ladite couche mince dans le substrat source,
  - b) la séparation de la couche mince d'avec le substrat source selon la zone de clivage,
- conformément à l'invention, le procédé comporte en outre, préalablement à l'étape b) :

- une formation d'une épaisseur de film de matériau entre la zone de clivage et la surface du substrat telle que cette épaisseur soit supérieure, égale ou voisine d'une épaisseur limite pour que le  
5 film soit autoporté, et

- une surfragilisation de la zone de clivage provoquée par un traitement thermique et/ou par l'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source.

10 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront mieux de la description qui va suivre, en référence aux figures des dessins annexés. Cette description est donnée à titre purement illustratif et non limitatif.

15

#### Brève description des figures

- La figure 1 est une coupe schématique d'un substrat source et illustre une opération d'implantation d'ions.

20 - La figure 2 est une coupe schématique du substrat source de la figure 1 et illustre la formation d'une couche d'épaisseur.

- La figure 3 est une coupe schématique du substrat source de la figure 2 et illustre une étape de  
25 fragilisation.

- La figure 4 est une coupe schématique d'une structure formée du substrat source de la figure 3, reporté sur un support cible.

30 - La figure 5 est une coupe schématique de la structure de la figure 4 après fracture de séparation du substrat source.

Description détaillée d'un mode de mise en oeuvre de  
l'invention

La description qui suit se rapporte à un  
5 transfert d'une couche mince de silicium sur un support  
cible de silice fondue (appelée abusivement quartz).

L'invention peut cependant être mise en oeuvre  
pour d'autres matériaux solides, qu'ils soient  
cristallins ou non. Ces matériaux peuvent être  
10 diélectriques, conducteurs, semi-isolants ou semi-  
conducteurs.

De même, le support cible peut être un support  
final ou intermédiaire, tel qu'une poignée, un substrat  
massif ou un substrat multicouche.

15 Le procédé peut en particulier être mis à  
profit pour le report de couches de  $\text{LiNbO}_3$  ou de semi-  
conducteurs III-V tel que AsGa, InP sur du silicium ou  
du SiC.

La figure 1 montre un substrat initial 10 en  
20 silicium. Celui-ci subit une implantation d'ions  
hydrogène indiquée avec des flèches 12. Cette  
implantation correspond à l'étape a<sub>1</sub>) du procédé.

L'implantation, effectuée par exemple avec une  
dose de  $6.10^{16}/\text{cm}^2$  et une énergie de 70 keV, permet de  
25 former des microcavités 14 dans le substrat 10 à une  
profondeur de l'ordre de 7000 Å.

Cette profondeur correspond également à  
l'épaisseur d'une couche mince 18. Celle-ci est  
délimitée à la surface du substrat par une zone 16,  
30 dite de clivage, comprenant les microcavités 14.

Antérieurement ou de préférence postérieurement à cette implantation, la couche mince superficielle 18 peut être soumise à d'autres traitements, connus en soi, pour la formation dans cette couche de composants 5 électroniques, optiques, ou mécaniques. Ces composants ne sont pas représentés sur la figure pour des raisons de clarté.

De même, pour une meilleure lisibilité des figures, les différentes couches ou caractéristiques 10 représentées, ne le sont pas selon une échelle uniforme. En particulier, les couches très minces sont représentées avec une épaisseur exagérée.

La figure 2 qui correspond à l'étape d'utilisation d'un épaisseur du procédé, montre le 15 dépôt d'une couche d'oxyde de silicium 20 d'une épaisseur de l'ordre de, ou supérieure à 5  $\mu\text{m}$ , sur la couche mince 18. La couche d'oxyde de silicium est par exemple déposée par un procédé de dépôt chimique en phase gazeuse assisté par plasma à une température de 20 300°C.

La couche d'oxyde de silicium 20 a un rôle d'épaisseur de la couche mince 18. En d'autres termes, elle a pour fonction de prévenir une 25 déformation de la couche mince sous l'effet de traitements thermiques ultérieurs.

La figure 3 correspond à l'étape de surfragilisation du procédé. Lors de cette étape, le substrat subit des traitements visant à fragiliser 30 davantage encore la zone de clivage 16.

Dans l'exemple illustré, on procède à un traitement thermique effectué à une température de

l'ordre de 450°C pendant une durée de l'ordre de 12 minutes.

Ce budget thermique est de préférence supérieur à 60% du budget thermique nécessaire pour obtenir une  
5 séparation uniquement par recuit. Une telle surfragilisation est possible avec une épaisseur suffisante de film.

On observe que le traitement thermique provoque une coalescence partielle des microcavités 14 de la  
10 zone de clivage 16.

Lors de cette opération, la couche de d'épaisseur 20 qui recouvre la couche mince 18, prévient sa déformation et en particulier prévient la formation de cloques.

15 En l'absence de cette couche, des cloques seraient susceptibles d'apparaître avec un traitement thermique à 450°C après une durée de l'ordre de 2 minutes ce qui correspond uniquement à un traitement thermique de 10% du traitement thermique nécessaire à  
20 la séparation.

Le traitement thermique peut être suivi par une étape de polissage de la face libre de la couche d'épaississeur 20 juste pour améliorer la rugosité de surface de façon à la préparer pour un collage  
25 moléculaire.

La figure 4 montre le report du substrat source 10 sur un support cible 30 qui, en l'occurrence, est une plaque de quartz.

Le report est effectué de façon à mettre en  
30 contact une face plane du support cible avec la face plane libre de la couche d'épaississeur 20.

Des forces d'adhérence moléculaire s'exerçant au niveau des faces mises en contact assurent la solidarisation (fixation) entre le substrat source et le support cible.

5           Lorsqu'une telle adhérence moléculaire n'est pas possible pour des raisons de nature des matériaux ou de qualité des surfaces, le report peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un liant ou d'une colle.

10           Les forces d'adhérence moléculaire peuvent être renforcées par exemple par un traitement thermique et/ou par des préparations de surface. Dans l'exemple illustré, et en raison des fortes différences de coefficients de dilatation thermique entre le silicium et le quartz, le traitement thermique est effectué à  
15           une température relativement basse, de l'ordre de 200°C pendant une durée de 20 heures.

          Ce traitement thermique peut contribuer à induire des contraintes telles que la fracture du substrat peut être obtenue selon cette zone.

20           La figure 5 illustre l'étape c) du procédé qui correspond à une fracture du substrat source. La fracture a lieu selon la zone de clivage et sépare la couche mince 18 de la partie restante du substrat 10. Cette dernière partie peut alors être réutilisée par  
25           exemple pour un nouveau transfert de couche mince.

          La couche mince 18 reste solidaire du support 30 par l'intermédiaire de la couche d'épaisseur 20.

          Dans un autre exemple, non représenté, où l'épaisseur de la couche mince est assez importante  
30           pour éviter des déformations, la couche d'épaisseur

peut être omise. La couche mince est alors directement en contact avec le support cible.

A titre d'exemple, on peut citer l'utilisation d'un substrat en SiC, qui est implanté à environ  
5 200 KeV de façon à obtenir un film sans épaisseur, d'environ 1,5  $\mu$ m. Dans cet exemple, la surfragilisation peut être obtenue sans épaisseur.

La fracture du substrat source peut être provoquée par l'exercice d'une force mécanique et/ou  
10 par un traitement thermique.

Dans l'exemple illustré, une lame de rasoir (non représentée) peut être insérée à la main au niveau de la zone fragilisée.

L'invention s'applique particulièrement bien à  
15 la réalisation d'une couche mince de silicium sur de la silice fendue dont l'intérêt principal est d'avoir un support transparent avec une couche de semi-conducteur pouvant comporter des composants.

#### 20 DOCUMENTS CITES

(1) FR-A-2 681 472 (US-A-5 374 564)

(2) FR-A2 738 671 (US-A-5 714 395)

25

(3) FR-A-2 748 851

(4) FR-A-2 767 416

30 (5) FR-A-2 755 537

**REVENDEICATIONS**

1. Procédé de transfert d'une couche mince (18) d'un substrat source (10) vers un support cible (30) comportant les étapes suivantes :

- 5 a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans le substrat source de façon à y former une zone (16), dite de clivage, qui délimite ladite couche mince (18) dans le substrat source,
- 10 b) le report du substrat source sur le support cible et la solidarisation de la couche mince avec le support cible,
- c) la séparation de la couche mince (18) d'avec le substrat source (10) selon la zone de clivage, caractérisé en ce qu'il comporte préalablement à
- 15 l'étape b) :
- la formation d'une épaisseur de film de matériau entre la zone de clivage et la surface du substrat telle que cette épaisseur soit supérieure, égale ou voisine d'une épaisseur limite pour que le film soit
  - 20 autoporté, et
  - une surfragilisation de la zone de clivage (16) provoquée par un traitement thermique et/ou par l'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source.

25 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la séparation de la couche mince (18) d'avec le substrat source (10) est provoquée par un traitement thermique et/ou par l'exercice de forces mécaniques.

30 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la surfragilisation comporte un traitement

thermique mis en oeuvre avec un budget thermique permettant la séparation.

4. Procédé selon la revendication 2; dans lequel le traitement thermique de séparation est choisi  
5 suffisant pour provoquer, lors de l'étape c), une séparation de la couche mince (18), par simple écartement du substrat source et du support cible.

5. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape c) et l'étape de surfragilisation  
10 comportent l'exercice de forces sous la forme d'une pression mécanique et/ou une tension mécanique et/ou des forces sous la forme d'une pression de gaz.

6. Procédé de transfert d'une couche mince (18) d'un substrat source (10) comportant les étapes  
15 suivantes :

a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans le substrat source de façon à y former une zone (16), dite de clivage, qui délimite ladite couche mince (18) dans le substrat source,  
20 b) la séparation de la couche mince (18) d'avec le substrat source (10) selon la zone de clivage, caractérisé en ce qu'il comporte préalablement à l'étape b) :

- une formation d'une épaisseur de film de matériau  
25 entre la zone de clivage et la surface du substrat telle que cette épaisseur soit supérieure, égale ou voisine d'une épaisseur limite pour que le film soit autoporté, et  
- une surfragilisation de la zone de clivage (16)  
30 provoquée par un traitement thermique et/ou par

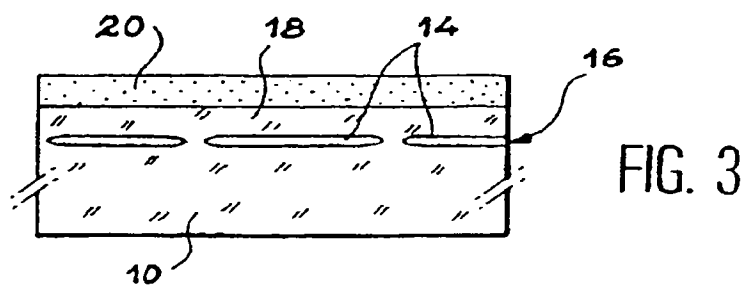
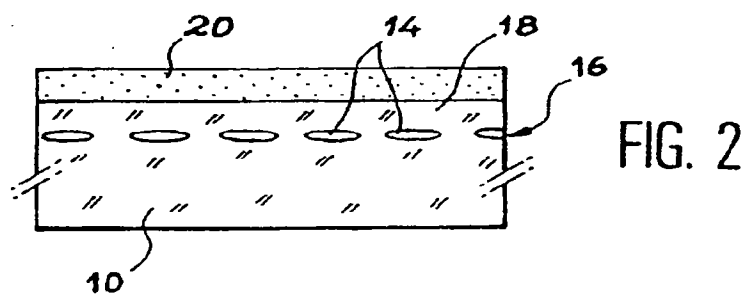
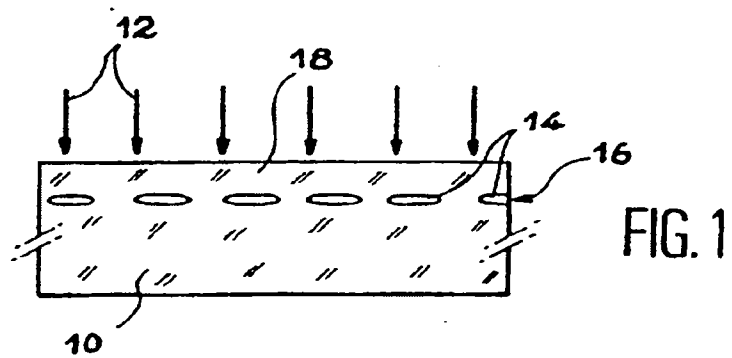
l'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape de formation d'une épaisseur de film consiste à réaliser l'étape a) d'implantation de façon à obtenir la zone de clivage à ladite épaisseur, le film étant alors constitué par la couche mince.

8. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape de formation d'une épaisseur de film comprend la réalisation d'une couche dite d'épaisseur (20) sur la couche mince, la couche mince et la couche d'épaisseur formant alors le film.

9. Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre la réalisation, avant l'étape b), de tout ou partie de composants micro-électroniques et/ou micro-mécaniques et/ou opto-électroniques.

1/2



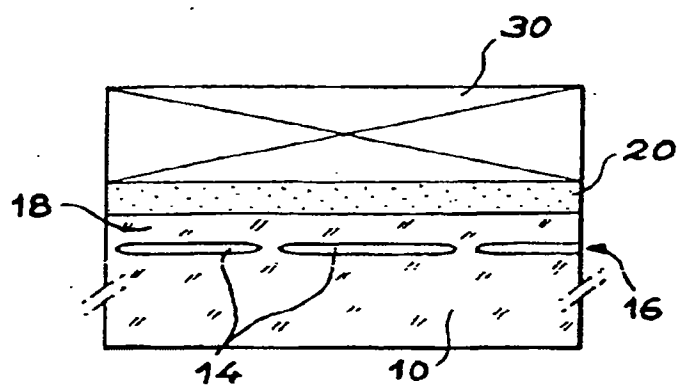


FIG. 4

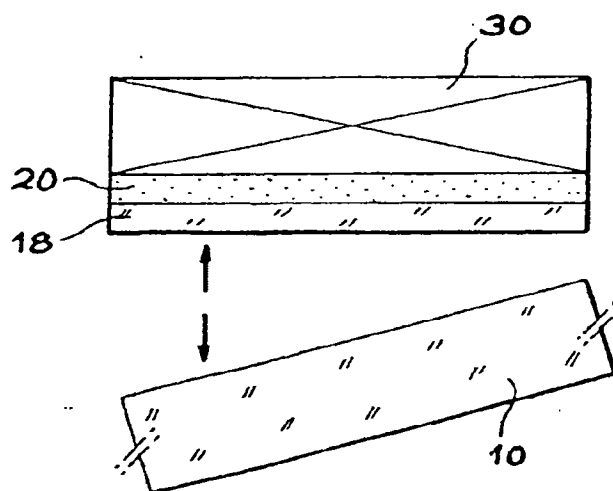


FIG. 5

REPUBLIQUE FRANÇAISE

2797347

INSTITUT NATIONAL

RAPPORT DE RECHERCHE

N° d'enregistrement  
national

de la

PRELIMINAIRE

PROPRIETE INDUSTRIELLE

établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

FA 579841  
FR 9910121

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	US 5 877 070 A (TONG Q-Y ET AL) 2 mars 1999 (1999-03-02) * abrégé; revendications *	1-4, 6, 7
X	EP 0 807 970 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 19 novembre 1997 (1997-11-19) * abrégé; revendications; figures * * colonne 6, ligne 17 - colonne 7, ligne 26 *	1-4, 6, 7, 9
A	EP 0 763 849 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 19 mars 1997 (1997-03-19) * abrégé; revendications; figures *	1, 2, 4, 6-8
A	US 5 909 627 A (EGLOFF RICHARD) 1 juin 1999 (1999-06-01) * abrégé; revendications; figures *	1, 6
A	EN W G ET AL: "THE GENESIS PROCESSTM: A NEW SOI WAFER FABRICATION METHOD" ANNUAL IEEE INTERNATIONAL SILICON-ON-INSULATOR CONFERENCE, US, NEW YORK, NY: IEEE, vol. CONF. 24, 1998, pages 163-164, XP000830696 ISBN: 0-7803-4501-0 * abrégé; figure 1 *	1, 6
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CL. 7)
		H01L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
30 mars 2000		Wirner, C
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>		

2

EPO FORM 1603 (04/99) (P04C11)